



MSL FPGA INC 晶片參數

■ 芯片概述

DS1230Y-70+ 是来自MSL FPGA INC美时龙的 256Kbit 非易失性静态随机存取存储器 (NVSRAM) ，采用并行接口设计，适用于需要掉电数据保护的工业及嵌入式系统。以下是其关键信息：

■ 核心参数

存储类型：NVRAM (非易失性静态随机存取存储器)	接口类型：并行接口访问时间：70ns
容量：256Kbit (32K × 8位)	工作电压：4.5V – 5.5V
封装：EDIP-28 (通孔安装)	温度范围：0°C 至 +70°C

■ 功能特性

非易失性：内置锂电池，断电后数据可保存至少10年。
自动保护：当VCC超出容差范围时，自动切换至锂电池供电并启用写保护。
兼容性：引脚兼容标准28引脚DIP封装，可直接替换32K×8静态RAM或EEPROM。
无写次数限制：相比EEPROM或闪存，NVSRAM无擦写寿命限制。

■ 应用场景

工业控制：(如PLC、仪器仪表)
医疗设备：(需长期数据保存)
替代传统EEPROM或闪存：(提升性能)